

10A、650V N沟道增强型场效应管

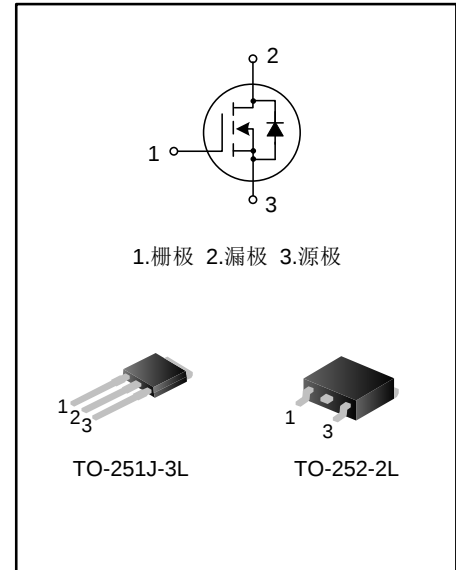
描述

SVF10N65CA N 沟道增强型高压功率 MOS 场效应晶体管采用士兰微电子 F-Cell™ 平面高压 VDMOS 工艺技术制造。先进的工艺及原胞设计结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。

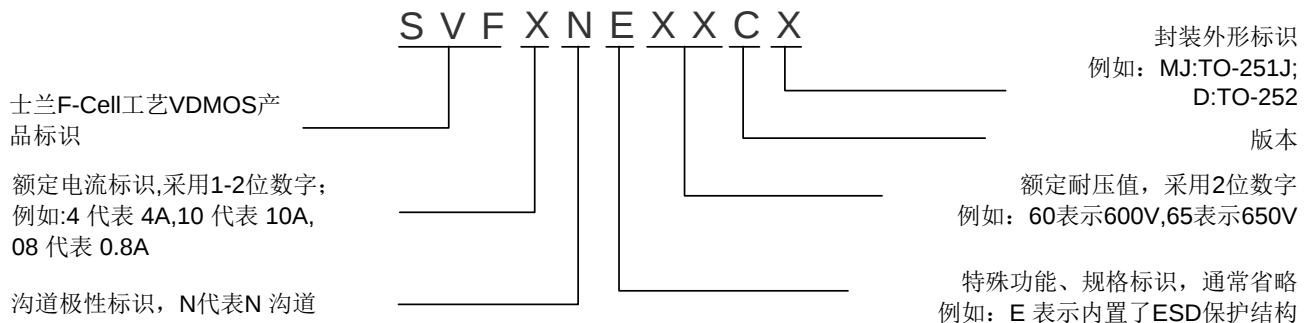
该产品可广泛应用于 AC-DC 开关电源，DC-DC 电源转换器，高压 H 桥 PWM 马达驱动。

特点

- ◆ 10A, 650V, $R_{DS(on)}$ (典型值)= $0.85\Omega @ V_{GS}=10V$
- ◆ 低栅极电荷量
- ◆ 低反向传输电容
- ◆ 开关速度快
- ◆ 提升了 dv/dt 能力



产品命名规则



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装
SVF10N65CAMJ	TO-251J-3L	10N65CA	无卤	料管
SVF10N65CAD	TO-252-2L	10N65CA	无卤	料管
SVF10N65CADTR	TO-252-2L	10N65CA	无卤	编带

极限参数(除非特殊说明, $T_c=25^{\circ}\text{C}$)

参 数		符 号	参数范围	单位
漏源电压		V _{DS}	650	V
栅源电压		V _{GS}	±30	V
漏极电流	T _C = 25°C	I _D	10.0	A
	T _C = 100°C		6.30	
漏极脉冲电流		I _{DM}	40	A
耗散功率（T _C =25°C）		P _D	148	W
- 大于 25°C 每摄氏度减少			1.18	W/°C
单脉冲雪崩能量（注 1）		E _{AS}	268.2	mJ
工作结温范围		T _J	-55~+150	°C
贮存温度范围		T _{stg}	-55~+150	°C

热阻特性

参 数	符 号	参数范围	单位
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	0.84	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.0	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

电性参数(除非特殊说明, $T_c=25^{\circ}\text{C}$)

参 数	符 号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0\text{V}, I_D=250\mu\text{A}$	650	--	--	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=650\text{V}, V_{GS}=0\text{V}$	--	--	1.0	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$	--	--	± 100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu\text{A}$	2.0	--	4.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10\text{V}, I_D=5.0$	--	0.85	0.95	Ω
输入电容	C_{iss}	$V_{DS}=25\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$	--	1035	--	pF
输出电容	C_{oss}		--	118	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	10.2	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=325\text{V}, R_G=25\Omega, I_D=10\text{A}$ (注 2, 3)	--	18.53	--	ns
开启上升时间	t_r		--	36.87	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	45.80	--	
关断下降时间	t_f		--	34.07	--	
栅极电荷量	Q_g	$V_{DS}=520\text{V}, I_D=10\text{A}, V_{GS}=10\text{V}$ (注 2, 3)	--	26.61	--	nC
栅极-源极电荷量	Q_{gs}		--	7.77	--	
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}		--	11.78	--	

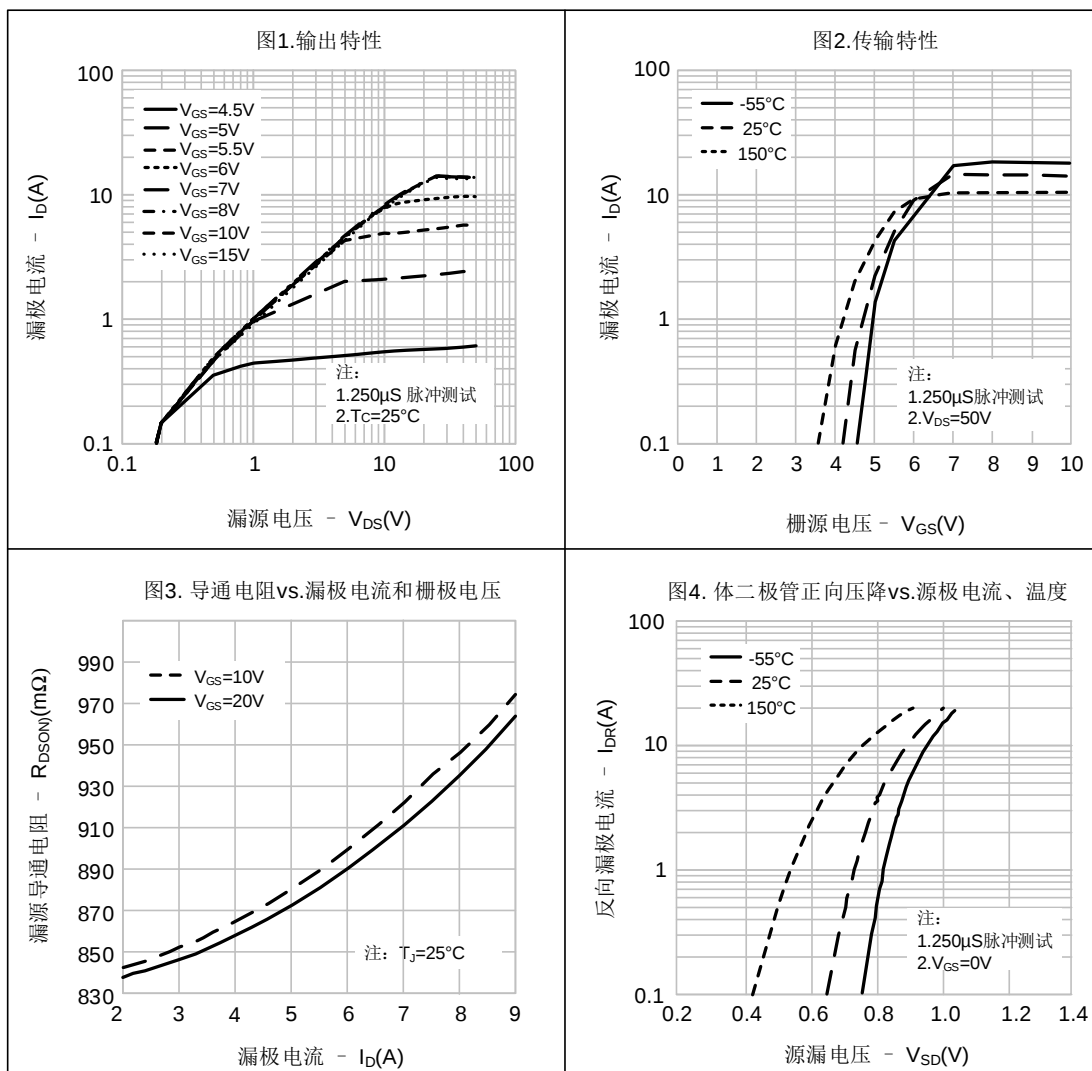
源-漏二极管特性参数

参 数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	I_S	MOS 管中源极、漏极构成的反偏	--	--	10	A
源极脉冲电流	I_{SM}	P-N 结	--	--	40	
源-漏二极管压降	V_{SD}	$I_S=10A$, $V_{GS}=0V$	--	--	1.3	V
反向恢复时间	T_{rr}	$I_S=10A$, $V_{GS}=0V$,	--	524.7	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}	$dI_F/dt=100A/\mu s$ (注 2)	--	4.40	--	μC

注:

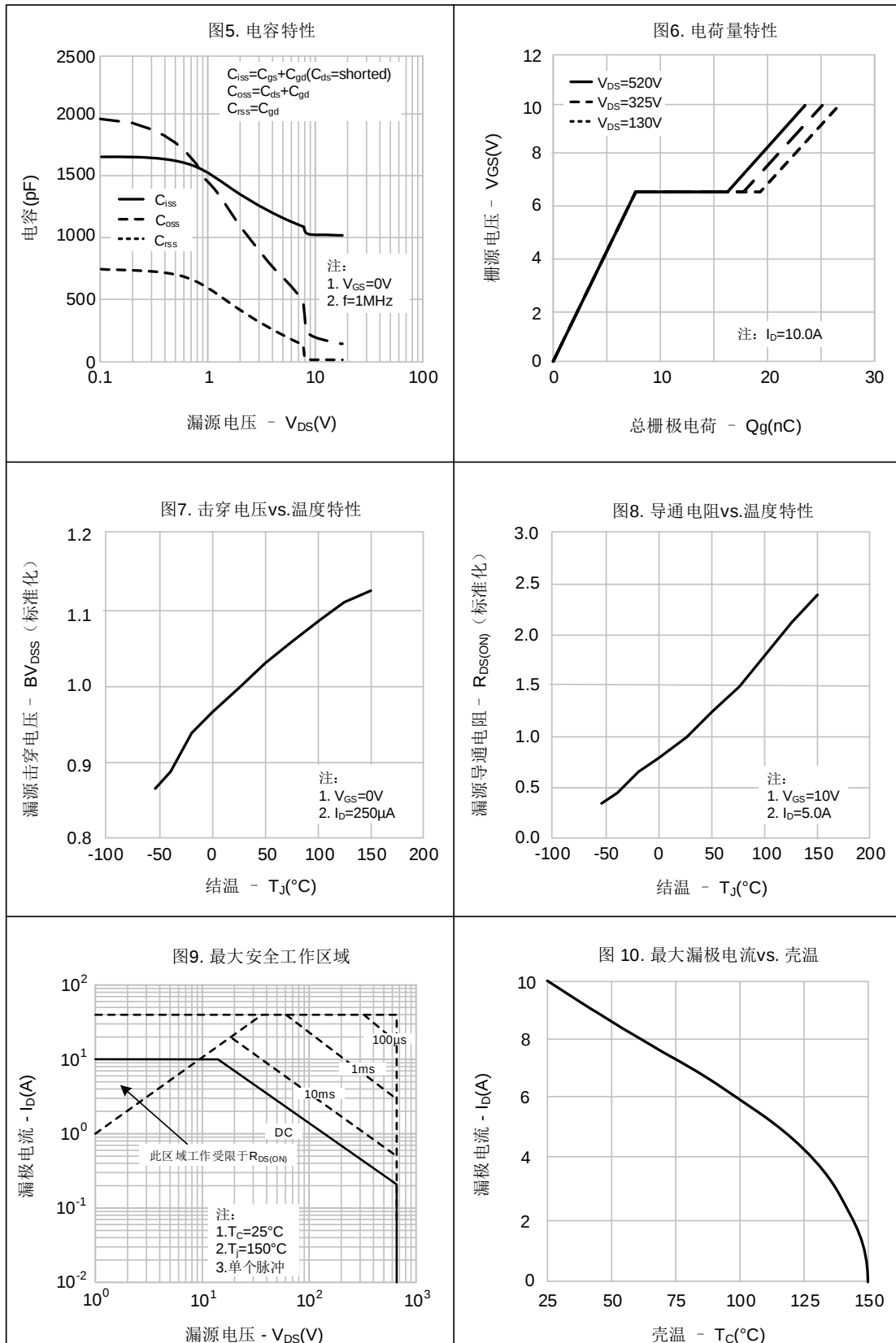
1. $L=30mH$, $I_{AS}=4.0A$, $V_{DD}=100V$, $R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_J=25^\circ C$;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$;
3. 基本上不受工作温度的影响。

典型特性曲线



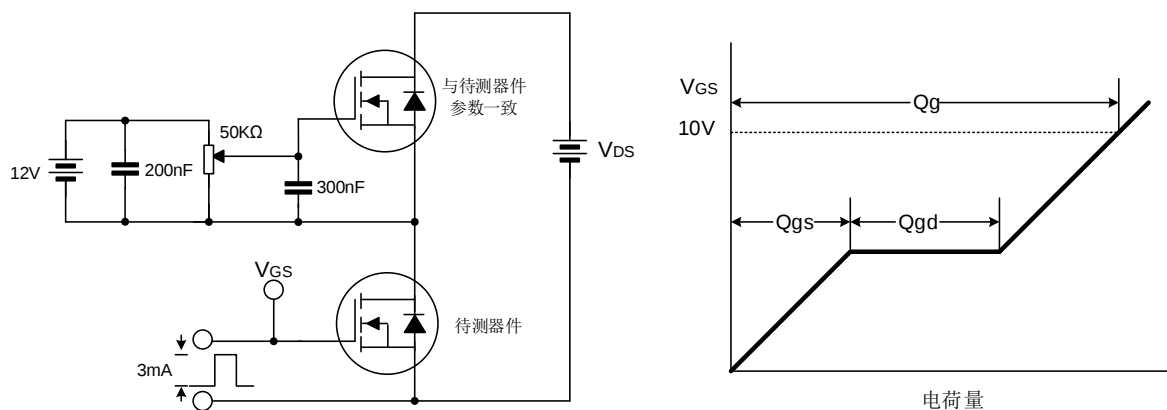


典型特性曲线 (续)

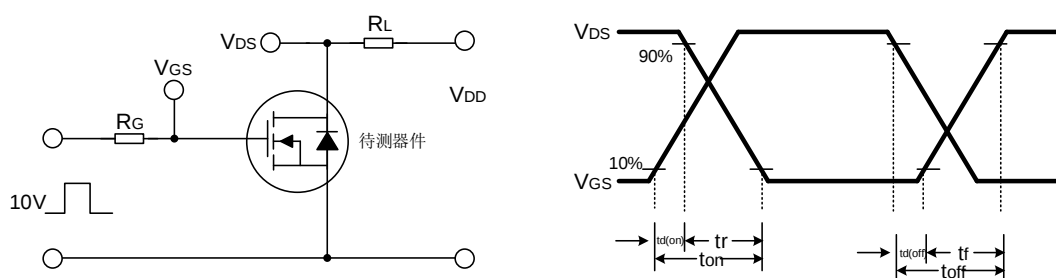


典型测试电路

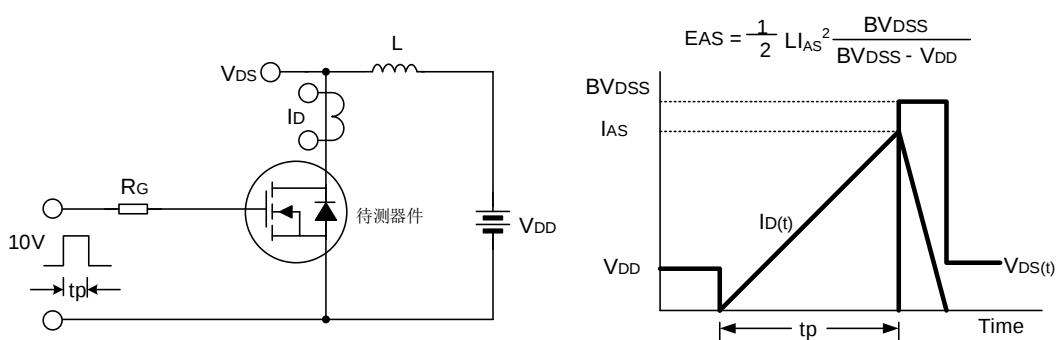
栅极电荷量测试电路及波形图



开关时间测试电路及波形图



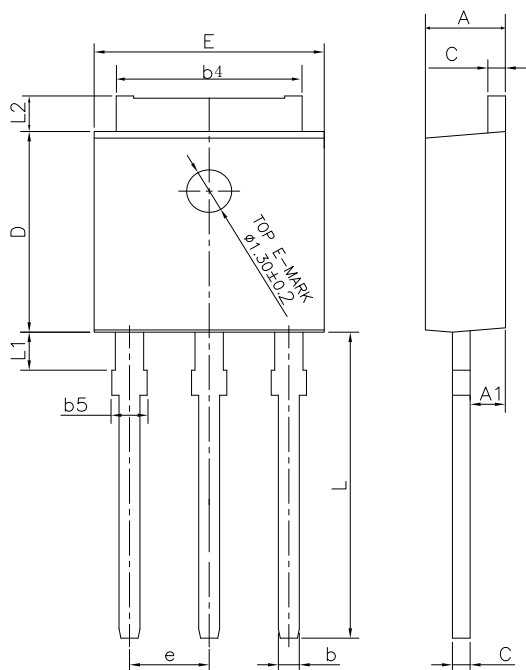
EAS测试电路及波形图



封装外形图

TO-251J-3L

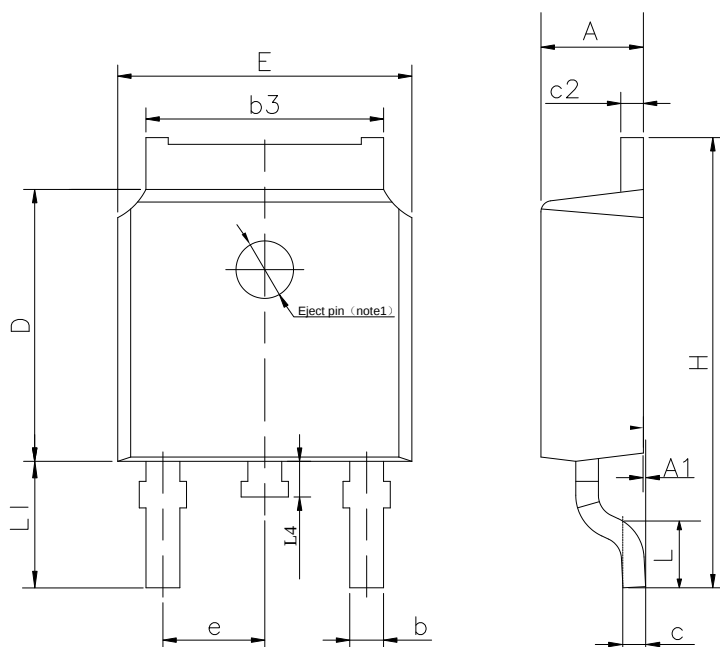
单位：毫米



SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	2.18	2.30	2.39
A1	0.89	1.00	1.14
b	0.56	---	0.89
b4	4.95	5.33	5.46
b5	---	---	1.05
c	0.46	---	0.61
D	5.97	6.10	6.27
E	6.35	6.60	6.73
e	2.29 BCS		
L	8.89	9.30	9.65
L1	0.95	---	1.50
L2	0.89	---	1.27

TO-252-2L

单位：毫米



SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	2.10	2.30	2.50
A1	0	---	0.127
b	0.66	0.76	0.89
b3	5.10	5.33	5.46
c	0.45	---	0.65
c2	0.45	---	0.65
D	5.80	6.10	6.40
E	6.30	6.60	6.90
e	2.30TYP		
H	9.60	10.10	10.60
L	1.40	1.50	1.70
L1	2.90REF		
L4	0.60	0.80	1.00

NOTE1 : There are two conditions for this position:has an eject pin or has no eject pin.

声明:

- ◆ 士兰保留说明书的更改权, 恕不另行通知! 客户在下单前应获取最新版本资料, 并验证相关信息是否完整和最新。
- ◆ 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
- ◆ 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

产品名称:	SVF10N65CA	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本: 1.2

修改记录:

1. 更新 TO-251J-3Lf 封装外形图

版 本: 1.1

修改记录:

1. 删除 TO-251Q-3L

版 本: 1.0

修改记录:

1. 正式版本发布
-
-